

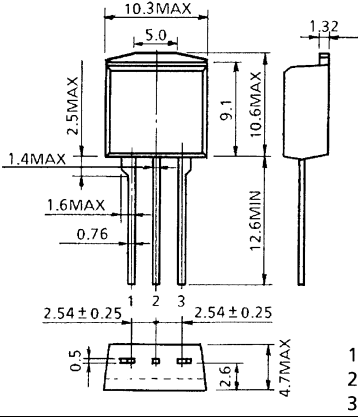
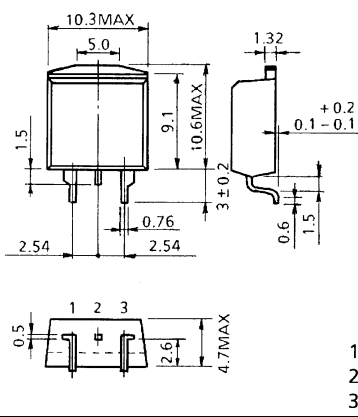
東芝双方向サイリスタ シリコンプレーナ形

SM6G48,USM6G48,SM6J48,USM6J48,SM6G48A
USM6G48A,SM6J48A,USM6J48A

○ 交流電力制御用

- ピーク繰り返しオフ電圧 : $V_{DRM}=400, 600V$
- 実効オン電流 : $I_T(RMS)=6A$
- ゲートトリガ電流 : $I_{GT}=30mA (Max.)$ (一般タイプ)
 : $I_{GT}=20mA (Max.)$ (高感度タイプ)

単位: mm

SM6G48, SM6J48, SM6G48A, SM6J48A	USM6G48, USM6J48, USM6G48A, USM6J48A
 1. T1 2. T2 3. ゲート	 1. T1 2. T2 3. ゲート
JEDEC —	JEDEC —
JEITA —	JEITA —
東 芝 13-10J1A	東 芝 13-10J2A

質量: 1.7 g (標準)

質量: 1.7 g (標準)

最大定格

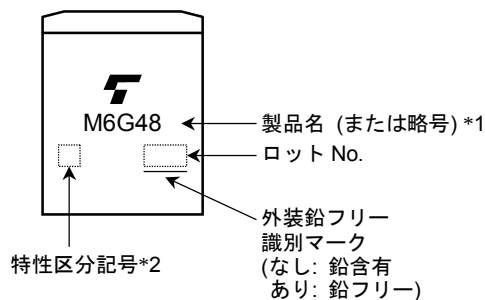
項目	記号	定格	単位
ピーク繰り返し オフ電圧	(U)SM6G48 (U)SM6G48A	400	V
	(U)SM6J48 (U)SM6J48A	600	
実効オン電流	$I_{T(RMS)}$	6	A
ピーク1サイクルサージオン電流	I_{TSM}	60(50Hz)	A
		66(60Hz)	
電流2乗時間積	I^2t	18	A^2s
臨界オン電流上昇率(注1)	di/dt	50	$A/\mu s$
ピークゲート損失	P_{GM}	5	W
平均ゲート損失	$P_{G(AV)}$	0.5	W
ピークゲート電圧	V_{GM}	10	V
ピークゲート電流	I_{GM}	2	A
接合温度	T_j	-40~125	°C
保存温度	T_{stg}	-40~125	°C

注1: $V_{DRM}=0.5 \times$ 定格電圧 $I_{TM} \leq 9A$ $t_{gw} \geq 10 \mu s$ $t_{gr} \leq 250ns$ $i_{gp} = I_{GT} \times 2.0$

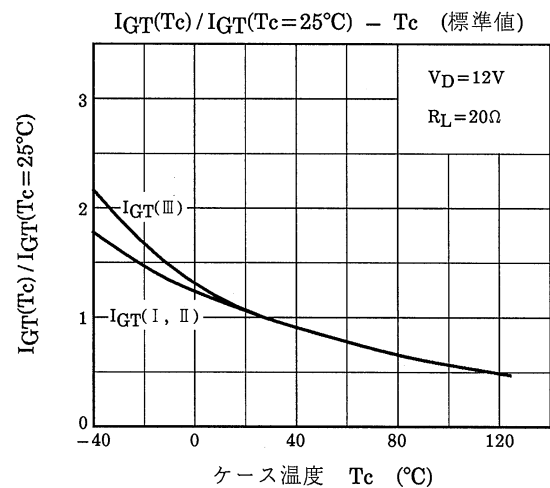
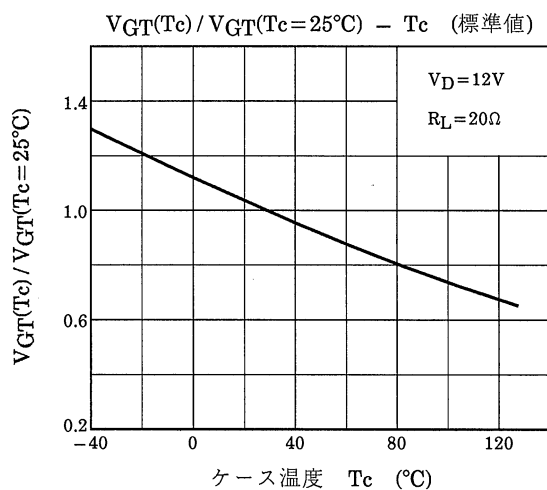
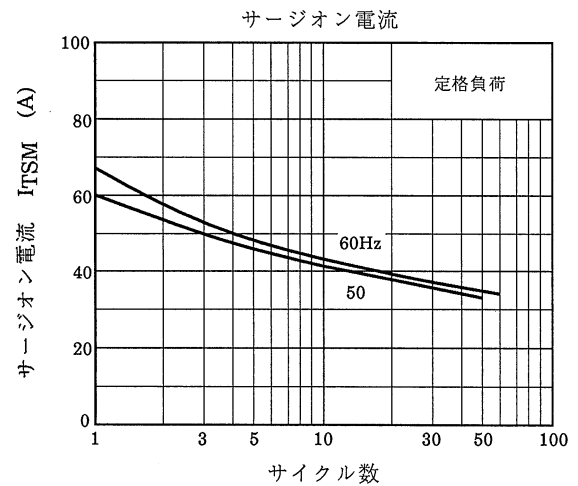
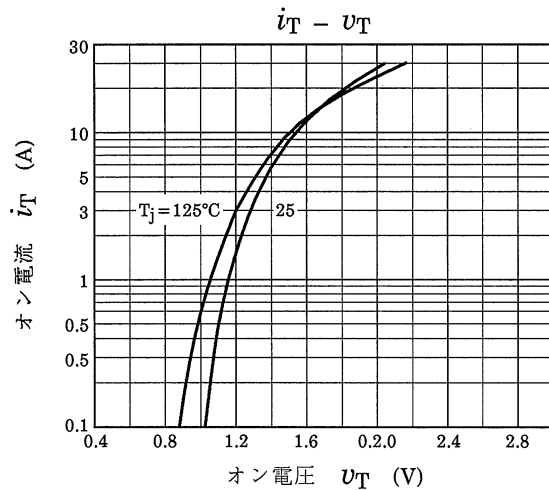
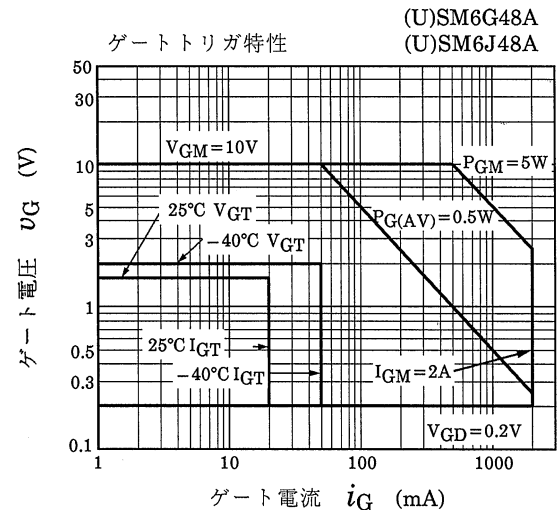
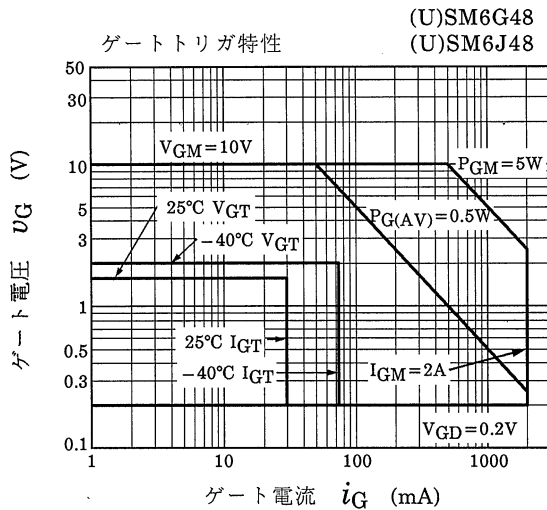
電気的特性 (Ta=25°C)

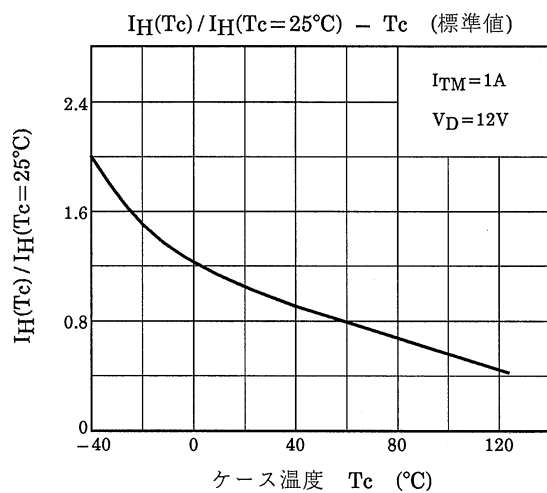
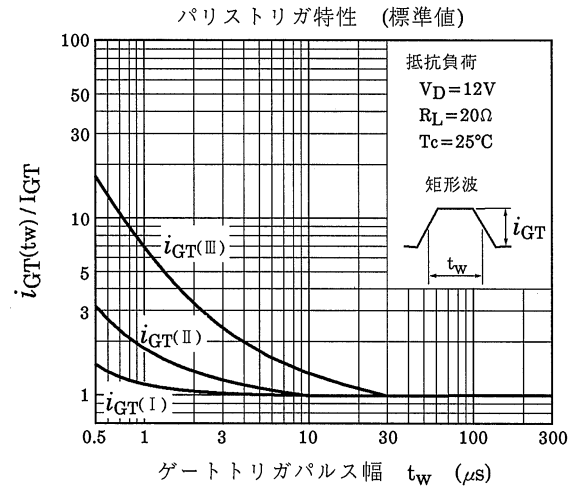
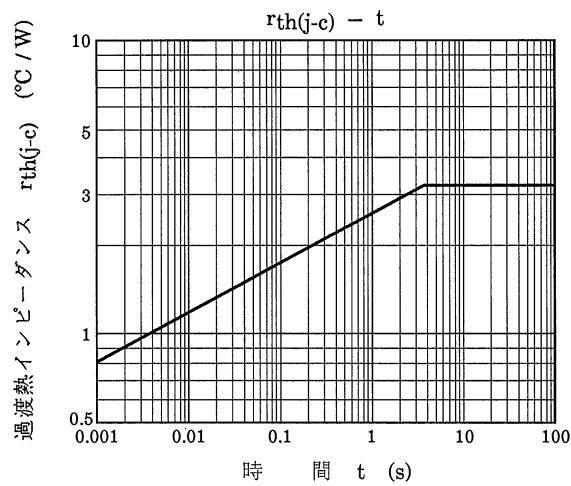
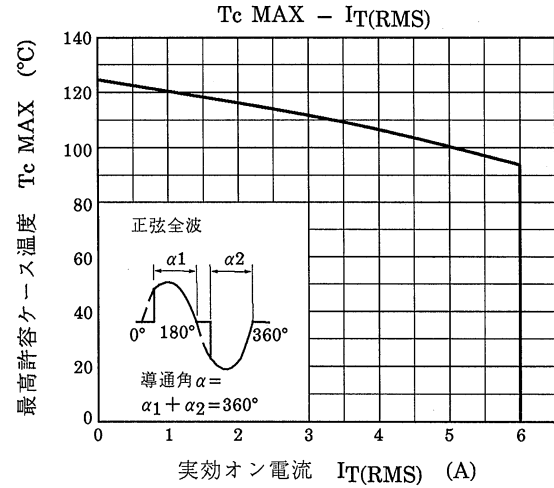
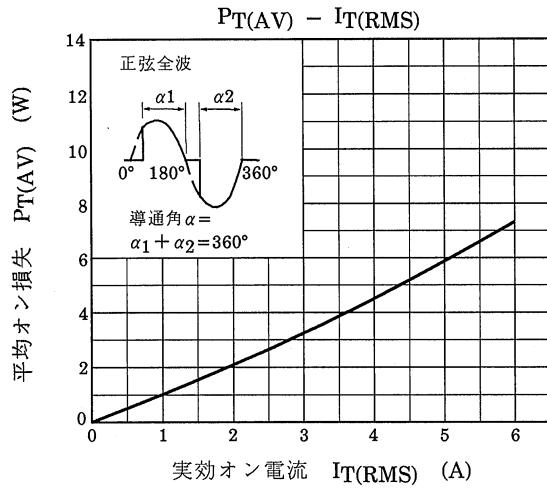
項目		記号	測定条件		最小	標準	最大	単位
ピーク繰り返しオフ電流		I _{DRM}	V _{DRM} =定格電圧		—	—	20	μA
ゲートトリガ電圧	I	V _{GT}	V _D =12V R _L =20Ω	T2 (+), ゲート (+)	—	—	1.5	V
	II			T2 (+), ゲート (—)	—	—	1.5	
	III			T2 (—), ゲート (—)	—	—	1.5	
	IV			T2 (—), ゲート (+)	—	—	—	
ゲートトリガ電流	(U)SM6G48 (U)SM6J48	I _{GT}	V _D =12V R _L =20Ω	T2 (+), ゲート (+)	—	—	30	mA
				T2 (+), ゲート (—)	—	—	30	
				T2 (—), ゲート (—)	—	—	30	
				T2 (—), ゲート (+)	—	—	—	
	(U)SM6G48A (U)SM6J48A			T2 (+), ゲート (+)	—	—	20	
				T2 (+), ゲート (—)	—	—	20	
				T2 (—), ゲート (—)	—	—	20	
				T2 (—), ゲート (+)	—	—	—	
ピークオン電圧		V _{TM}	I _{TM} =9A		—	—	1.5	V
ゲート非トリガ電圧		V _{GD}	V _D =定格電圧, T _c =125°C		0.2	—	—	V
保持電流		I _H	V _D =12V, I _{TM} =1A		—	—	50	mA
熱抵抗 (接合-ケース間)		R _{th(j-c)}	交流		—	—	3.2	°C / W
臨界オフ電圧上昇率	(U)SM6G48 (U)SM6J48	dv / dt	V _{DRM} =定格電圧, T _j =125°C 指数関数上昇波形		—	300	—	V / μs
	(U)SM6G48A (U)SM6J48A				—	200	—	
転流時臨界オフ電圧上昇率	(U)SM6G48 (U)SM6J48	(dv / dt) c	V _{DRM} =400V, T _j =125°C (di / dt) c=−3.3A / ms		10	—	—	V / μs
	(U)SM6G48A (U)SM6J48A				4	—	—	

現品表示



	製品名 (または略号)	製品名
*1	M6G48	SM6G48, SM6G48A
		USM6G48, USM6G48A
	M6J48	SM6J48, SM6J48A
		USM6J48, USM6J48A
*2	なし	SM6G48, SM6J48
		USM6G48, USM6J48
	A	SM6G48A, SM6J48A
		USM6G48A, USM6J48A





当社半導体製品取り扱い上のお願い

030519TAA

- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用いただく場合は、半導体製品の誤作動や故障により、生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、機器の安全設計を行うことをお願いします。
なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用いただくと共に、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などご確認ください。
- 本資料に掲載されている製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）に使用されることを意図しています。特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器（原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など）にこれらの製品を使用すること（以下“特定用途”という）は意図もされていませんし、また保証もされていません。本資料に掲載されている製品を当該特定用途に使用することは、お客様の責任でなされることとなります。
- 本資料に掲載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社および第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 本資料に掲載されている製品を、国内外の法令、規則および命令により製造、販売を禁止されている応用製品に使用することはできません。
- 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。